

第3回 TUAT-YNU ナノテク合同研究会

日 時 平成 19 年 12 月 20 日 (木)

場 所 横浜国立大学 電子情報工学科棟 3 階 演習室 II

アクセス http://www.ynu.ac.jp/access/acc_index.html (交通)
http://www.ynu.ac.jp/access/acc_19.html (学内 43 番の建物です)

時 間 12:00~16:00

[プログラム]

- [1] SPM ナノリソグラフィによる NiFe 細線の狭窄化と MR 効果
石橋禎史(横浜国立大 M1)
- [2] 電子線露光プロセスによる強磁性ナノデバイスの作製と磁気特性制御
本山基彰(東京農工大 M2)
- [3] SPM 局所酸化における反応電流の測定~金属と半導体の差異
畷田泰之(横浜国立大 M2)
- [4] マイグレーションを用いたトンネルデバイス作製に関する研究
久米 彌(東京農工大 B4)
- [5] SPM 局所酸化における反応電流の測定~たわみ量依存性
進藤僚平(横浜国立大 B4)
- [6] SOI 基板を用いたシリコン単電子デバイスに関する研究
高城拓見(東京農工大 M2)